

半导体学报

第 11 卷 第 4 期 1990 年 4 月

目 录

- 杂质和空位对 AlAs/GaAs 超晶格电学性质的影响.....
.....王思哥 章立源 王怀玉 (243)
- 等电子杂质 Sb 对 InP 中缺陷的影响.....叶式中 杨保华 徐 岭 (253)
- InGaAsP 相位调制器的研究.....
.....邬祥生 李允平 吴学海 吕章德 龚连根 周 萍 吴长川 (258)
- 离子注入硅形成绝缘埋层的红外反射谱分析.....
.....方子韦 俞跃辉 林成鲁 邹世昌 (262)
- 应变层多量子阱 InGaAs-GaAs 的光电流谱研究.....
.....方晓明 沈学础 侯宏启 冯 巍 周钧铭 (270)
- $n^+ - i - n^+$ 结构的电极附近结区电场对 SCLC 法确定薄 a-Si:H 膜隙态密度的
影响——计算机模拟分析.....林鸿生 林 臻 (279)
- 光学多层介质膜与多量子阱集成器件.....林世鸣 (288)
- BF_2^+ 注入束的沾污和对结深的影响.....李金华 邹世昌 (294)
- 紫外光/臭氧干法去除光刻胶速率的提高.....谈凯声 (301)
- 短沟道薄硅膜 CMOS/SIMOX 电路的研究.....
.....陈南翔 石涌泉 王忠烈 黄 澈 (305)
- 研究简报**
- 可见光阶梯衬底内条形半导体激光器.....
.....杜国同 张晓波 赵方海 邹 峥 高鼎三 (311)
- 研究快报**
- 量子阱中 δ 掺杂的光谱特性.....徐仲英 谢茂海 徐 强 郑宝真 孔梅影 (316)
- 氧化锌-铅酞菁复合膜对氧化性气体的新的传感特性.....吴瑞华 (319)